

InGaAs PIN фотодиод 2 мм, ТО-корпус — техническое описание

P/N :WIT3-2000L

ОСОБЕННОСТИ:

Высокая чувствительность
Низкий темновой ток; спектральная чувствительность 900–1740 нм

ПРИМЕНЕНИЕ:

Газовые сенсоры; оптические датчики

Измерители оптической мощности
Промышленная автоматика
Аппаратура регистрации
излучения; измерение
спектральной чувствительности

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Параметр	Обозначение	Ед. изм.	Мин.	Макс.
Рабочая температура	TSTG	°C	-40	85
Температура хранения	TC	°C	-40	85
Температура (время) пайки	TL	°C		260 / 10 с
Обратное напряжение	VCC	V		4

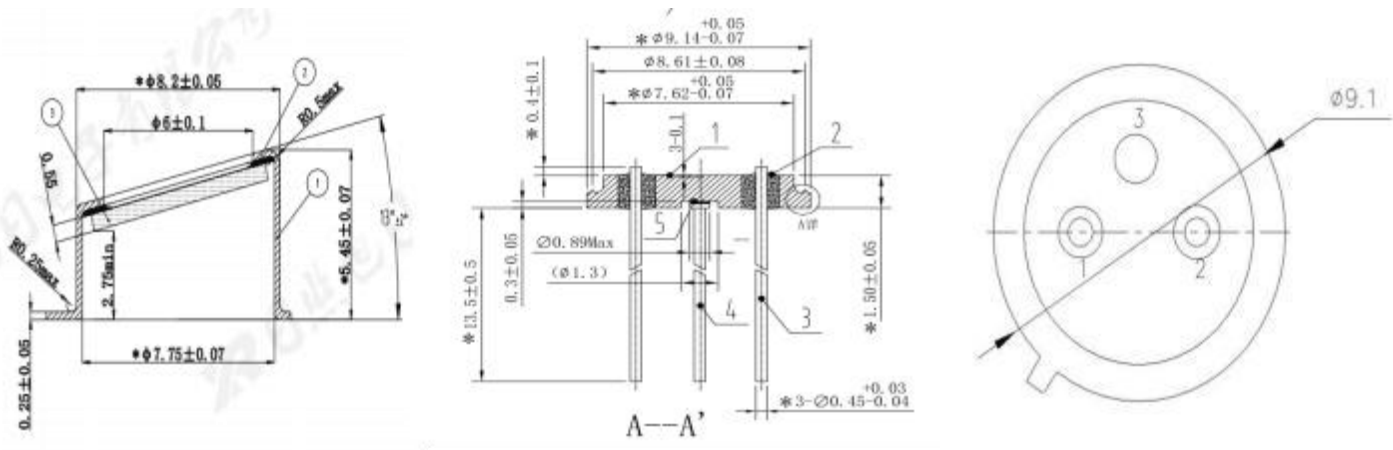
Электрооптические характеристики (T=25 °C):

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	D	-	-	2000	-	мкм
Чувствительность	R	$\lambda=1653\text{nm}$	0.9	0.95	-	A/Вт
Темновой ток	ID	VBR=-5V	-		20	нА
Спектральная чувствительность	λ	-	900	-	1740	нм
Емкость	C	VBR=-5V		160	230	пФ

ПРИМЕЧАНИЕ:

При хранении, транспортировке и использовании рекомендуются соответствующие меры защиты от ЭСР.

Назначение выводов и габаритный чертёж:



№ вывода	Название
1	PD+
2	PD-
3	GND